

	<h2 style="color: red;">FQD10N20LTM</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQD10N20LTM
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK
	<b>Datenblätter:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <a href="#">1.FQD10N20LTM.pdf</a></li> <li> <a href="#">2.FQD10N20LTM.pdf</a></li> </ul>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 9110 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD10N20LTM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	9110 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 7.6A (Tc) 2.5W (Ta), 51W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 51W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	360 mOhm @ 3.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	830pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQD10N20LTMDKR

FQD10N20LTM ist neu im Original, Suche FQD10N20LTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD10N20LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD10N20LTM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD10N20LTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK</p>	 <p><b>FQD10N20LTF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK</p>	 <p><b>FQD10N20D</b> F FQD10N20D F</p>	 <p><b>FQD10N20TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK</p>
 <p><b>FQD10N60C</b> FAIRCHI FQD10N60C FAIRCHI</p>	 <p><b>FQD10N20TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK</p>	 <p><b>FQD10N20TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK</p>	 <p><b>FQD10N20LTF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr


Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

